BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-279543

(43) Date of publication of application: 02.10.2003

(51)Int.CI.

GO1N 27/62 GO1N 27/64 GO1N 33/00

(21)Application number: 2002-081606

(22)Date of filing:

22.03.2002

(71)Applicant: MITSUBISHI HEAVY IND LTD

(72)Inventor: YAMAKOSHI HIDEO

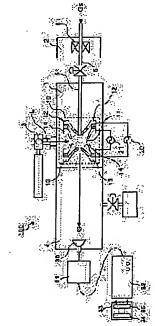
FUTAMI HIROSHI DANNO MINORU

TSURUGA SHIGENORI KURIBAYASHI SHIZUMA

(54) DETECTION METHOD FOR CHEMICAL SUBSTANCE AND DETECTION DEVICE THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To selectively detect an isomer with high correlation with dioxins from among precursors of the dioxins. SOLUTION: The detection device 100 for this chemical substance with a vacuum ultraviolet light lamp 3 ionizes TCB of the precursor of the dioxins in an exhaust gas Gs with this vacuum ultraviolet light lamp 3. Then a TCB ion is fragmentized by providing energy to the TCB ion with a TICKLE waveform having a frequency component corresponding to the orbit resonance frequency of the TCB ion. Thereafter, the mass of a fragment thereof is measured with a mass spectrometer 4 and a fragment pattern is determined. The isomer concentration of the TCB contained in the exhaust gas Gs is determined with mathematical calculation based on the predetermined fragment pattern of the TCB, by utilizing that the fragment pattern is different by the isomer when the isomer of the TCB is fragmentized.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.03.2002

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3626940

[Date of registration]

10.12.2004

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-279543 (P2003-279543A)

(43)公開日 平成15年10月2日(2003.10.2)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I		7-71-1 (多考)			
G01N 27/0		G01N	27/62	ZAE	ZABV		
27/0		2	27/64	В			
33/0		3	33/00		D		
	·	審查請求	有	請求項の数7	OL	(全 14 頁)	
(21)出顧番号	特顧2002-81606(P2002-81606)	(71)出願人		06208 重工業株式会社			
(22)出顧日	平成14年3月22日(2002.3.22)		東京	都港区港南二丁目	16番5号	}	
		(72)発明者	山越	英男			
	·		横浜	市金沢区幸浦一丁	目8番垍	1 三菱重	
			工業株式会社基盤技術研究所内				
		(72)発明者	二見	二見 博			
			横浜	市金沢区幸浦一丁	目8番地	1 三菱重	

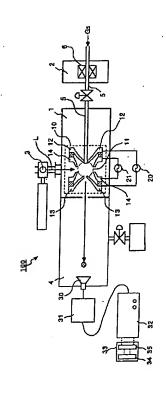
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 化学物質の検出方法及び検出装置

.(57)【要約】

【課題】 ダイオキシン類の前駆体のうち、ダイオキシン類と相関の高い異性体を選択的に検出すること。

【解決手段】 との化学物質の検出装置100は、真空 紫外光ランプ3を備えており、との真空紫外光ランプ3 によって、排ガスGs中のダイオキシン類前駆体である TCBをイオン化する。そして、TCBイオンの軌道共鳴周波数に対応する周波数成分を持つTICKLE波形でTCBイオンにエネルギーを与えてTCBイオンをフラグメント化する。その後、質量分析計4によって、とのフラグメントの質量が計測され、フラグメントパターンを求める。次に、TCBの異性体をフラグメント化すると、異性体によってフラグメントパターンが異なることを利用し、予め求めておいたTCBの異性体のフラグメントパターンに基づいて排ガスGs中に含まれるTCBの異性体濃度を数学的計算により求める。



工業株式会社横浜研究所内

弁理士 酒井 宏明

(74)代理人 100089118

(特許請求の範囲)

[請求項1] ダイオキシン類の前駆体をイオン化する イオン化工程と、

このイオン化工程によってイオン化された前記前駆体の イオンにエネルギーを与えてフラグメントイオン化する フラグメント化工程と、

前記前駆体のフラグメントイオンの質量から当該フラグ メントイオンのフラグメントパターンを求める質量分析 工程と、

オンの濃度指標と、前記前駆体の異性体の標準気体から 求めた当該異性体のフラグメントの濃度比指標とから、 前記前駆体中における異性体の濃度を求める演算工程

を有することを特徴とする化学物質の検出方法。

【請求項2】 上記イオン化工程においては、上記前駆 体のイオン化ポテンシャルよりも大きく、当該イオン化 ポテンシャルと上記前駆体のイオンの解離エネルギーと の和よりも小さいエネルギーを上記前駆体に与えること を特徴とする請求項1 に記載の化学物質の検出方法。

【請求項3】 上記イオン化工程においては、上記前駆 体のイオン化ポテンシャルよりも高く当該イオン化ポテ ンシャルに4 e Vを加算した値以下のエネルギーを上記 前駆体に与えることを特徴とする請求項 1 に記載の化学 物質の検出方法。

【請求項4】 上記イオン化工程においては、波長が5 Onm以上200nm以下の光によって上記前駆体をイ オン化することを特徴とする請求項1に記載の化学物質 の検出方法。

【請求項5】 上記イオン化工程においては、真空紫外 光を上記前駆体に照射することを特徴とする請求項1に 記載の化学物質の検出方法。

【請求項6】 上記フラグメント化工程においては、上 記前駆体のイオンの軌道共鳴周波数に対応する周波数成 分を持つTICKLE波形で上記前駆体のイオンにエネ ルギーを与えるととを特徴とする請求項1~5のいずれ か1項に記載の化学物質の検出方法。

【請求項7】 ダイオキシン類の前駆体をイオン化する イオン化手段と、とのイオン化手段によってイオン化さ れた前記前駆体のイオンにエネルギーを与えてフラグメ 40 ントイオン化するフラグメント化手段と、

前記前駆体のフラグメントイオンの質量から当該フラグ メントイオンのフラグメントパターンを求める質量分析 手段と、

当該質量分析手段で求めた前記前駆体のフラグメントイ オンの濃度指標と、前記前駆体の異性体の標準気体から 求めた当該異性体のフラグメントの濃度比指標とから、 前記前駆体中における異性体の濃度を求める演算手段 ٤,

を有することを特徴とする化学物質の検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、化学物質の検出 方法及び検出装置に関し、特に、どみ焼却炉等から排出 される排ガス中にどく微量含まれるダイオキシン類前駆 体の異性体を選択的に検出するための化学物質の検出方 法及び化学物質の検出装置に関するものである。

2

[0002]

【従来の技術】近年、どみ焼却施設から排出される燃焼 当該質量分析工程で求めた前記前駆体のフラグメントイ 10 排ガス中に含まれるダイオキシン類を低減させるため に、排ガス中に含まれるダイオキシン類をリアルタイム に計測して焼却炉の燃焼制御に用いる試みが始まってい る。ダイオキシン類の計測には、髙分解能のGC/MS (ガスクロマトグラフ/質量分析計) による計測法が知 られているが、との方法は複雑な前処理を要するため、 試料を採取してから結果が判明するまでに数週間を要す るのが現状である。したがって上記のようなリアルタイ ム制御に適用するととは極めて困難である。

> 【0003】また、燃焼排ガス中に存在するダイオキシ 20 ン類の濃度は極めて低いため、燃焼排ガス中のダイオキ シン類を直接計測するととは難しく、これを焼却炉など の燃焼制御に使用する程度の精度で計測するには時間も 要してしまう。したがって、現在では燃焼排ガス中のダ イオキシン類を直接計測するよりも、ダイオキシン類の 前駆体等、ダイオキシン類の濃度と相関の高い指標物質 による代替計測技術が開発されつつある。

【0004】ととで、励起効率の異なるレーザーによっ て前駆体をイオン化するレーザー法によれば、前駆体を 高感度で計測できる。特に、共鳴増感多光子イオン化法 (REMPI: Resonance-enhanced Multiphoton Ioniz ation) は、燃焼排ガス中のダイオキシン類前駆体であ るクロロベンゼン類を実用的な感度で計測できる。クロ ロベンゼン類には異性体が存在するが、ダイオキシン類 との相関は異性体によって異なる。このため、ダイオキ シン類と相関の低い異性体を測定したのでは、ダイオキ シン類の発生量を推定する精度が低くなり、燃焼制御に 不具合が生ずることもある。

【0005】したがって、より高い精度でダイオキシン 類の発生量を推定するためには、ダイオキシン類と相関 の高い異性体を選択的に計測することが必要である。ま た、焼却炉等の燃焼制御に使用するためには、数秒から 長くとも1分程度で分析を完了する必要があるので、迅 速に計測できることが要求される。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、波長可変レ ーザーを使用して、クロロベンゼン類のS。→S,遷移を 励起すれば、異性体によってスペクトルが異なるので、 これを利用して特定の異性体を選択的にイオン化して検 出するととができる。詳しくは、R.Zimmermann,H.J.Heg

50 er, R.Dorfner, U.Bosel, M.Blumenstock, D.Lenor and

3

A.Kettrup, Combust Sci. and Tech., Vol. 134, pp.8 7-101(1998)を参照されたい。この方法によれば、異性体を選択的に検出でき、また、検出に要する時間も短いため、焼却炉等の燃焼制御に適用できる可能性がある。しかし、波長可変レーザーは長時間安定して一定の波長を維持することが困難であり、実験室においては異なる異性体を選択的にイオン化できても、焼却炉等の燃焼状態を長時間監視するような使い方は事実上困難である。また、波長可変レーザーは、塩素が2個以上ついているものについては感度が低く、実用的な感度を得ることが 10できない。

【0007】一方、選択性の高くない大気圧化学イオン化法等のイオン化法でイオン化した後、特定質量数のイオンをイオントラップに保持し、その後イオンに解離エネルギーを与えて解離生成物(以下フラグメントの質量数を計測して、目的とする計測対象物質を選択して計測することができる。なお、この詳細については、馬場章夫他訳、「有機化学のためのスペクトル解析法」、化学同人(2000)を参照されたい。しかし、この方法は、異なる化学種を選択的に計測するのみであり、クロロベンゼン等の異性体を選択的に検出するためには、ガスクロマトグラフを併用する必要がある。このため、数秒から長くとも1分程度で分析を完了させる必要のある焼却炉等の燃焼制御に使用することはできなかった。

[0008] そこで、この発明は、上記に鑑みてなされたものであって、焼却炉や加熱炉その他の燃焼炉を運転している最中であってもその燃焼条件を制御できる程度に前駆体の検出速度を向上させること、ダイオキシン類の推定精度を高くすること、ダイオキシン類と相関の強い異性体を選択的に検出することのうち少なくとも一つを達成できる化学物質の検出方法及び化学物質の検出装置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するために、請求項1に係る化学物質の検出方法は、ダイオキシン類の前駆体をイオン化するイオン化工程と、このイオン化工程によってイオン化された前記前駆体のイオンにエネルギーを与えてフラグメントイオン化するフラグメント化工程と、前記前駆体のフラグメントイオンの質 40 置から当該フラグメントイオンのフラグメントパターンを求める質量分析工程と、当該質量分析工程で求めた前記前駆体のフラグメントイオンの濃度指標と、前記前駆体の異性体の標準気体から求めた当該異性体のフラグメントの濃度比指標とから、前記前駆体中における異性体の濃度を求める演算工程と、を有することを特徴とする

【0010】本発明者らは鋭意研究の結果、トリクロロベンゼン等のダイオキシン類前駆体の異性体をフラグメント化すると、異性体によってフラグメントパターンが 50

異なることを見出した。そして、焼却炉排ガス等の実ガスに含まれるダイオキシン類前駆体のフラグメントバターンは、この前駆体の異性体のフラグメントバターンを重ね合わせたものであり、各々の異性体が干渉して、前駆体のフラグメントバターンが変化することはないことを見出した。本発明はこれを利用してなされたものであって、異性体の標準ガスから求めたフラグメントバターンに基づいて実際の排ガスに含まれるダイオキシン類前駆体の異性体濃度を数学的に求めるものである。

【0011】との発明に係る化学物質の検出方法は、複 数存在するダイオキシン類の前駆体の異性体濃度を、前 駆体のフラグメントイオンの濃度指標と、この前駆体の 異性体の標準気体から求めた当該異性体のフラグメント の濃度比指標とから求めるようにしてある。より具体的 には、ダイオキシン類前駆体のフラグメントパターンを 求める。そして、前駆体の異性体の標準ガスを用いて、 各異性体のフラグメントパターンを求め、ととから各異 性体における各フラグメントイオンの濃度比を求める。 【0012】ととで、ダイオキシン類前駆体のフラグメ ントバターンは、この前駆体の異性体のフラグメントバ ターンを重ね合わせたものである。したがって、ダイオ キシン類前駆体フラグメントイオンの濃度は、異性体の 濃度と、前記ダイオキシン類前駆体フラグメントイオン と同じ質量数である異性体フラグメントイオンの濃度比 とをそれぞれの異性体について乗算し、その乗算結果を 加算して求めることができる。ここで、ダイオキシン類 前駆体フラグメントイオンの濃度及び異性体フラグメン トイオンの濃度比は既知であるから、異性体の濃度を未 知数とした方程式ができる。そして、フラグメントイオ ンは複数あるため、とのような方程式が複数成立する。 したがって、これらの方程式を連立させて解くことによ って、各異性体の濃度を求めることができる。

【0013】 このように、ダイオキシン類前駆体の各異性体の濃度を知ることができるので、ダイオキシン類と相関の低い異性体とダイオキシン類と相関の高い異性体との濃度を知ることができる。これによって、すべての前駆体からダイオキシン類と相関の高い異性体の濃度を選択的に計測することができる。その結果、ダイオキシン類の発生量を従来よりも高い精度で推定することができるので、焼却炉等の燃焼状態を従来よりも高い精度で制御できる。これにより、ダイオキシン類の発生量を従来よりも低くできる。

[0014]また、質量分析装置等を用いた質量分析工程によって、ダイオキシン類前駆体のフラグメントパターンを求めるので、短時間でフラグメントパターンを求めることができる。そして、ダイオキシン類と相関の高い異性体の濃度は、数学的計算によって求めることができるので、電子計算機等の計算手段によれば極めて短時間で計算結果を得ることができる。その結果、この化学物質の検出方法においては、短い時間でダイオキシン類

と相関の高い異性体の濃度を求めることができ、ダイオ キシン類をリアルタイムで測定できる。ここで、質量分 析工程においては、特に飛行時間計測方式のものを使用 すると、計測時間を短くできるので好ましい。

【0015】とこで、前駆体のフラグメントイオンの濃 度指標には、例えば、前駆体のフラグメントイオンを質 量分析した際におけるフラグメントパターンの信号強度 が利用できる。質量分析においては、フラグメントイオ ンの数によって得られる信号強度が変化するので、この 信号強度はフラグメントイオンの濃度と比例するからで 10 果、夾雑物除去に要するエネルギーを低く抑えることが ある。また、異性体のフラグメントの濃度比指標には、 例えば、異性体のフラグメントイオンを質量分析した際 におけるフラグメントパターンのそれぞれの信号強度 を、各異性体の全濃度を表す指標で除算したものを使用 するととができる。

【0016】また、イオン化工程には後述する真空紫外 光を照射する方法や、波長可変レーザーあるいはその髙 調波を用いるとともできる。さらに、真空紫外光の波長 を持つレーザー、エキシマランプを使用してもよく、ま た、例えばHeイオン等のイオンを粒子加速器で打ち出 20 して、排ガス中に含まれる前駆体に衝突させてもよい。 さらに、電子ビームをセクターで分離して10eV程度 のエネルギーを持つものを取り出し、排ガス中に含まれ る前駆体に衝突させてもよい。との他にも、例えば、光 子当たり4~5eVのエネルギーを持つ紫外レーザー光 を用い、2光子イオン化過程においてイオン化させても よい。またフェムト秒パルスレーザーのように、ピーク 強度の高いレーザー光を集光させた場合、光子によって 生ずる光電場でクロロベンゼン類をイオン化させてもよ いし、さらに電子吸収のない近赤外領域の波長において イオン化してもよい。また、化学イオン化、エレクトロ スプレーイオン化、あるいは高速電子衝突イオン化等に よって前駆体をイオン化してもよい。フラグメント化工 程では、後述するTICKLE波形を前駆体のイオンに 与える他、髙速電子線を衝突させたり、レーザー光を照 射したりするととによって前駆体のイオンをフラグメン ト化するととができる。

【0017】なお、ダイオキシン類とは、一般にダイオ キシンやフランやコプラナーPCBと呼ばれる分子を含 むものである。また、前駆体には、例えばトリクロロベ 40 ンゼン、ジクロロベンゼン、モノクロロベンゼン等のベ ンゼン類や、トリクロロフェノール等のフェノール類が 含まれる。このような前駆体の中で、特にダイオキシン 類と相関の高いものを使用することが好ましい。

[0018]また、請求項2に係る化学物質の検出方法 は、請求項1に記載の化学物質の検出方法において、上 記ィオン化工程においては、上記前駆体のイオン化ポテ ンシャルよりも大きく、当該イオン化ポテンシャルと上 記前駆体のイオンの解離エネルギーとの和よりも小さい エネルギーを上記前駆体に与えることを特徴とする。

【0019】このため、この化学物質の検出方法におい ては前駆体を壊さずにイオン化できるので、上記化学物 質の検出方法の奏する作用・効果の他に、イオン化効率 を高くして質量分析工程における検出感度を高くできる という作用・効果を奏する。また、このイオン化におい ては、イオン化に要するエネルギーを適度に設定してい るため、無闇に各種の分子を解離したりイオン化したり することがない。このため、夾雑物の発生が非常に少な いので、除去すべき夾雑物も極めて少なくなる。その結 できるので、残すべき前駆体であるダイオキシン類前駆 体を壊さないで済み、質量分析工程における検出感度を 髙くできる。

6

【0020】また、請求項3に係る化学物質の検出方法 は、請求項1に記載の化学物質の検出方法において、上 記イオン化工程においては、上記前駆体のイオン化ポテ ンシャルよりも高く当該イオン化ポテンシャルに4eV を加算した値以下のエネルギーを上記前駆体に与えるこ とを特徴とする。また、請求項4に係る化学物質の検出 方法は、請求項1に記載の化学物質の検出方法におい て、上記イオン化工程においては、波長が50nm以上 200 n m以下の光によって上記前駆体をイオン化する ことを特徴とする。また、請求項5に係る化学物質の検 出方法は、請求項1に記載の化学物質の検出方法におい て、上記イオン化工程においては、真空紫外光を上記前 駆体に照射することを特徴とする。

【0021】とのように、イオン化工程において前駆体 にエネルギーを与える場合には、イオン化ポテンシャル よりも高く当該イオン化ポテンシャルに4eVを加算し た値以下であることが望ましい。また、光のエネルギー によって前駆体をイオン化する場合には、その波長を5 0 n m以上200 n m以下とすることが望ましい。そし て、このような光を発生させる光源として真空紫外光ラ ンプを使用すると、真空紫外光を容易に得ることができ るので好ましい。

【0022】また、請求項6に係る化学物質の検出方法 は、請求項1~5のいずれか1項に記載の化学物質の検 出方法において、上記フラグメント化工程においては、 上記前駆体のイオンの軌道共鳴周波数に対応する周波数 成分を持つTICKLE波形で上記前駆体のイオンにエ ネルギーを与えることを特徴とする。

【0023】との化学物質の検出方法では、フラグメン ト化工程においてTICKLE波形をダイオキシン類の 前駆体イオンに与えるととによってこれをフラグメント 化する。とのため、前駆体の質量数と同程度の質量数を 持つ不純物があっても、この影響を排除して正確に計測 できる。また、イオン化の際に発生する夾雑物も極めて 少ないため、ダイオキシン類の前駆体をフラグメント化 する場合には、目的とする当該前駆体を効率的にフラグ 50 メント化できる。その結果、ほとんどすべてのダイオキ

ĺ

シン類前駆体のフラグメントを質量分析手段の計測対象 とすることができるので、質量分析手段の検出感度を高 くできる。この作用と上述したダイオキシン類と相関の 高い異性体を選択的に検出する作用とによって、より緻 密に燃焼制御ができる。

【0024】また、請求項7に係る化学物質の検出装置 は、ダイオキシン類の前駆体をイオン化するイオン化手 段と、このイオン化手段によってイオン化された前記前 駆体のイオンにエネルギーを与えてフラグメントイオン 化するフラグメント化手段と、前記前駆体のフラグメン 10 トイオンの質量から当該フラグメントイオンのフラグメ ントパターンを求める質量分析手段と、当該質量分析手 段で求めた前記前駆体のフラグメントイオンの濃度指標 と、前記前駆体の異性体の標準気体から求めた当該異性 体のフラグメントの濃度比指標とから、前記前駆体中に おける異性体の濃度を求める演算手段と、を有すること を特徴とする。

[0025] との発明に係る化学物質の検出装置は、イ オン化手段と、フラグメント化手段と、質量分析手段 と、演算手段とを備える。そして、複数存在するダイオ 20 キシン類との濃度相関を予め求めておく。 キシン類の前駆体の異性体濃度を、前駆体のフラグメン トイオンの濃度指標と、この前駆体の異性体の標準気体 から求めた当該異性体のフラグメントの濃度比指標とか ち求めるようにしてある。このため、ダイオキシン類と 相関の低い異性体とダイオキシン類と相関の高い異性体 との濃度を知ることができる。これによって、すべての 前駆体からダイオキシン類と相関の高い異性体の濃度を 選択的に計測するととができる。その結果、ダイオキシ ン類の発生量を従来よりも高い精度で推定することがで きるので、焼却炉等の燃焼状態を従来よりも高い精度で 30 制御でき、ダイオキシン類の発生量を従来よりも低くで きる。

[0026]また、この化学物質の検出装置は、質量分 析手段によってダイオキシン類前駆体のフラグメントバ ターンを求めるので、短時間でフラグメントパターンを 求めるととができる。そして、ダイオキシン類と相関の 高い異性体の濃度は、数学的計算によって求めることが できるので、コンピュータを利用した演算手段によれば 極めて短時間で計算結果を得ることができる。その結 果、との化学物質の検出方法においては、短時間でダイ 40 オキシン類と相関の高い異性体の濃度を求めることがで き、ダイオキシン類をリアルタイムで測定できる。とと で、質量分析手段には、特に飛行時間計測方式のものを 使用すると、計測時間を短くできるので好ましい。

[0027]

【発明の実施の形態】以下、との発明につき図面を参照 しつつ詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこ の発明が限定されるものではない。また、下記実施の形 態における構成要素には、当業者が容易に想定できるも の或いは実質的に同一のものが含まれる。また、下記実 50 施の形態における構成要素には、当業者が容易に想定で きるものが含まれるものとする。

8

【0028】(実施の形態1)との発明は、ダイオキシ ン類前駆体の異性体をフラグメント化すると、異性体に よってフラグメントパターンが異なることを利用し、こ のフラグメントパターンに基づいて実際の排ガスに含ま れるダイオキシン類前駆体の異性体濃度を求める点に特 徴がある。以下の説明においては、ダイオキシン類前駆 体としてトリクロロベンゼン(以下TCBという)を使 用した場合について説明する。TCBを使用したのは、 TCBについては異性体によってダイオキシン類との濃 度相関が異なるというととが既に判明しており、利用し やすい物質だからである。

【0029】なお、TCBの他にも、ダイオキシン類前 駆体としてテトラクロロベンゼン、ジクロロフェノー ル、あるいはトリクロロフェノール等を使用することが できる。なお、これらの物質を使用する場合には、GC /MS (ガスクロマトグラフ/質量分析計) 法等の既存 の分析方法によって、これらの物質の異性体毎にダイオ

【0030】実際の測定においては、前駆体であるTC Bをイオン化した後フラグメント化し、質量分析手段に よってフラグメントパターンを求める。一方、TCBの 各異性体について、とれらの標準ガスを用いて予めフラ グメントパターンを得ておく。そして、とのフラグメン トパターンに基づいて、前駆体であるTCBに含まれる 異性体の濃度を数学的に求める。

【0031】との発明におけるイオン化手段及びフラグ メント化手段には、様々な手段が利用できる。ここで は、真空紫外光によってTCBをイオン化し、これをR F(Radio Frequency: 高周波)リングによるイオント ラップに閉じ込めて、TICKLE波形をTCBイオン に与えるTICKLE手段によってフラグメント化する 手順について説明する。

【0032】なお、本発明に適用できるイオン化手段及 びフラグメント化手段はこれに限定されるものではな い。他のイオン化手段としては、例えば、光子当たり4 ~5eVのエネルギーを持つ紫外レーザー光を用い、2 光子イオン化過程においてイオン化させることもでき る。またフェムト秒パルスレーザーのように、ピーク強 度の高いレーザー光を集光させた場合、光子によって生 ずる光電場でクロロベンゼン類をイオン化させてもよい し、さらに電子吸収のない近赤外領域の波長においてイ オン化してもよい。また、化学イオン化、エレクトロス プレーイオン化、あるいは髙速電子衝突イオン化等のイ オン化手段によって、排ガスG s 中におけるクロロベン ゼン類をイオン化してもよい。

【0033】また、他のフラグメント化手段としては、 例えば、髙速電子線を衝突させたり、レーザー光を照射 したりする手段が使用できる。ただし、使用するフラグ

メント化手段によって、得られるフラグメントパターン は異なるので、各異性体の標準ガスをフラグメント化さ せたときと同じフラグメント化手段を使用する必要があ

【0034】図1は、この発明の実施の形態1に係る化 学物質の検出装置を示す説明図である。との化学物質の 検出装置100は、イオン化室1と、ガス導入装置2 と、イオン化手段である真空紫外光ランプ3と、質量分 析手段である飛行時間型の質量分析計4とを備えてい る。イオン化室1にはイオントラップ手段であるRFリ ングを備えたRFイオントラップ装置10が備えられて いる。とれは、内部に形成される高周波電界によって、 イオン化された排ガス中の前駆体をトラップ11内に閉 じ込めておく。との発明においては、ダイオキシン類と 相関の強いTCBを前駆体としてイオン化し、トラップ 11内に閉じ込める。

【0035】イオントラップ手段には電界や磁界その他 の電磁気学的力によってイオンを内部に閉じ込めるもの が使用できる。そして、電界や磁界等はそれぞれ単独で てもよい。とのようなイオントラップ手段としてはいく つかの種類が知られており、中でも髙周波電界が内部に 形成される上記RFイオントラップ装置10は取り扱い が比較的容易であるため好ましい。また、他のイオント ラップ手段としては、このRF型の他、直流電圧と静磁 場とによるペニング(Penning)トラップを使用すると ともできる。

[0036] イオントラップ手段であるRFイオントラ ップ装置10は、第一エンドキャップ12と第二エンド キャップ13とRFリング14とから構成されており、 三次元四重極型である。図1に示すように、RFリング 14は、第一エンドキャップ12と第二エンドキャップ 13との内部に配置されている。また、RFリング14 にはトラップ電圧を印加するための高周波電源装置21 が接続されており、RFリング14にトラップ電圧とし て髙周波電圧を印加する。との髙周波によって、イオン 化された排ガス中の前駆体その他の物質がトラップ11 内に閉じ込められる。また、第一及び第二エンドキャッ プ12及び13には任意波形発生手段である任意波形発 生装置20が接続されており、後述するSWIFT及び TICKLE時には両エンドキャップ間に特定の周波数 を持つ電圧を印加する。

[0037]ガス導入装置2にはガス噴射管5が備えら れており、ガス噴射管5は、パルスバルブのようなオリ フィスを用いた開閉弁あるいはキャピラリ管により形成 されている。ガス噴射管5に導入された焼却炉等の排ガ スGsはイオン化室1に導入される。ガス噴射管5の周 囲にはヒータ6が設けられている。ヒータ6は前駆体が ガス噴射管5の内壁に付着することを防止するための加 熱装置である。

【0038】イオン化室1は、前駆体にエネルギーを与 えてイオン化するためのイオン化手段として真空紫外光 ランプ3を備えている。真空紫外光ランプ3は、Ar、 Kr、Xe等の希ガスや、H₁、O₂、Cl₂等をAr、 Heに添加したガスの放電により真空紫外光しを発生す る。本実施の形態においては、121.6 n mの波長を 持つ、水素プラズマからのLyman α光を用いてい

[0039] 真空紫外光ランプ3は、放電するガスの種 類を変えるととで、発生する真空紫外光の光子エネルギ 一量を変えるとができる。とのため、前駆体のイオン 化ポテンシャルに合わせて、これよりも大きく、且つ前 駆体を解離させない程度の光子エネルギーを与えること ができる。とれによって、光子エネルギー量より高いイ オン化ポテンシャルを持つ混在物質のイオン化を阻止す ると共に、前駆体のフラグメント化を抑制することがで

【0040】また、イオン化手段は、真空紫外光ランプ 3に代えて、レーザーあるいはその髙調波を用いること 使用してもよく、またこれらを適宜組み合わせて使用し 20 もできる。この場合、波長可変レーザーを使用すること により、発生する光子エネルギー量を変化させること で、イオン化する物質を選別することができる。波長可 変レーザーには、周知のものを用いることができる。な お、この発明には50mm以上200mm以下の波長を もつ真空紫外光が適用でき、より好ましくは100nm 以上200nmであり、不要なフラグメント発生をより 少なく抑える観点からは112nm以上138nmの範 囲が望ましい。

> 【0041】さらに、前駆体にエネルギーを与えてイオ ン化する手段としては、真空紫外光の波長を持つレーザ ー、エキシマランプを使用してもよい。また、例えばH eイオン等のイオンを粒子加速器で打ち出して、イオン 化室1内の排ガスG s 中に含まれる前駆体に衝突させて もよい。さらに、電子ビームをセクターで分離して10 e V程度のエネルギーを持つものを取り出し、イオン化 室1内の排ガス中に含まれる前駆体に衝突させてもよ 64

【0042】質量分析手段である飛行時間型の質量分析 計4は、イオン化室 1 内でイオン化された排ガス中の前 駆体のイオンについて、その質量を計測することで前駆 体を特定する。イオン化された前駆体は、上記RFイオ ントラップ装置10の第二エンドキャップ13にパルス 状の引出し電圧を印加することによって質量分析計4に 導入され、質量分析計4内を飛行する。飛行したイオン はイオン検出器30によって検出され、ここで検出され た信号はプリアンプ31によって増幅された後、データ 処理装置32に取り込まれデータ処理される。なお、本 実施の形態においては、イオン検出器にマイクロチャネ ルプレートが用いられており、イオンの検出感度を高め 50 ている。質量分析計4はその飛行時間を計測する。飛行

10

時間と飛行物質の質量との間には高度の対応関係がある ので、飛行時間から飛行物質の質量を検出し、この質量 から物質を同定するのである。

11

【0043】次に、図2を用いてこの化学物質の検出装 置100を用いて排ガス中の検出対象であるダイオキシ ン類の前駆体を検出する手順について説明する。図2 は、この発明の実施の形態1に係る化学物質の検出方法 を示すフローチャートである。との実施の形態において は、ダイオキシン類の前駆体としてTCBを使用してい る。なお、TCBには3種類の異性体が存在する。ま ず、イオン化室 1 に焼却炉の排ガスG s を導入する(ス テップS101)。

[0044]次に、真空紫外光ランプ3からイオン化室 1内に導入された排ガスGsに対して真空紫外光Lを照 射し、排ガスGsが真空紫外光しから光子エネルギーを 受け取ってイオン化される(ステップS102)。とと で、検査対象物質である前駆体のイオン化ポテンシャル は8.5~10.0eVの範囲である。また、上述した ように、本実施の形態で使用する真空紫外光は121. 6 n mの波長を持っており、その光子エネルギーは1 0.1eVである。とのように、前駆体のイオン化ポテ ンシャルよりもやや大きい程度のエネルギーを与えるた . め、余分なエネルギーを前駆体に与えないで前駆体をイ オン化できる。

【0045】その結果、イオン化した前駆体である前駆 体を効率よく計測できるようになった。これは、真空紫 外光によるイオン化においてはフラグメントの発生が非 常に少ないため、イオン化した前駆体のほとんどすべて を質量分析計4の計測対象とすることができるからであ る。特に、焼却炉からの排ガス中Gs中には極めて微量 30 の前駆体しか存在しないため、この効果は大きい。ま た、真空紫外光によってイオン化すれば、トラップ11 のトラップ効率低下を抑えることができる。

【0046】ととで、フラグメント化したイオンが多い 場合には、トラップ 1 1 内に閉じ込められているイオン によって生ずるイオンの作るポテンシャルがトラップの ポテンシャルを打ち消すように作用する。しかし、この 真空紫外光によるイオン化では、余分なフラグメントイ オンの発生を極めて小さく抑えることができるので、R Fイオントラップ装置10のトラップ効率低下を小さく するととができる。

[0047] さらに、真空紫外光でイオン化すれば、次 に説明するSWIFT電圧を低く抑えることができる。 ことで、SWIFTは、不純物を除去するために特定の 周波数を持つ電圧波形をトラップ11の第一エンドキャ ップ12と第二エンドキャップ13間に与えることによ ってイオンの軌道を変える操作をいう。なお、SWIF Tの正式な名称はStored Waveform Inverse Fourier Tr ansformであり、詳細は、文献"Development of a Capil lary High-performance Liquid Chromatography Tandem 50 量数が近似する不純物を分離する操作である。そして、

Mass Spectrometry System Using SWIFT Technol ogy in an IonTrap/Reflectron Time_of_flight Mass S pectrometer" Rapid Communication in mass spectrome try, vol. 11 1739-1748(1997) を参照されたい。

12

【0048】フラグメントの発生が多いイオン化方法に おいては、SWIFTの過程で除去しておくべき質量数 に、前駆体である前駆体、あるいは他の物質を親分子と する大量のフラグメントが発生してしまう。これをSW IFTで除去するためには非常に大きな電圧を必要とす るため、出力の大きなSWIFT電圧発生装置(任意波 形発生器)が必要である。一方、SWIFT電圧を大き くすると、壊したい質量数以外の質量数を持つ分子も壊っ してしまうので、残したい前駆体も壊してしまう。その 結果、質量分析においては分析精度の低下を招いてしま

【0049】との発明に係るイオン化においてはフラグ メントの発生が非常に少ないため、SWIFTの過程で 除去すべきフラグメントも極めて少なくなる。その結 果、SWIFT電圧を低く抑え、且つ残すべき前駆体も 20 壊さないで済むので、上記問題点はほとんど回避でき る。また、SWIFT後に残った親分子へ後述するTI CKLEをかける場合やCOOLINGしたりする場合 にも、フラグメントの多いイオン化方法では種々の親分 子からフラグメントが発生してしまう。その結果、目的 とする前駆体以外のフラグメントが不純物として含まれ る結果、質量分析の精度低下を引き起としていた。しか し、との発明に係るイオン化方法によれば、イオン化の 際に発生するフラグメントが極めて少ないため、この問 題点もほとんど回避できる。

【0050】次にSWIFTについて説明する。これ は、排ガス中に存在している前駆体以外の不要物質を除 去するための操作である。このために、RFイオントラ ップ装置10の第一エンドキャップ12と第二エンドキ ャップ13との間に、任意波形発生装置20によって取 り除きたい物質の軌道共鳴周波数に対応した広域帯の周 波数で電圧を印加する。これによって、この発明に係る 不純物除去手段を形成している。なお、この広域帯の周 波数からは、前駆体の質量数の周波数に対応する軌道共 鳴周波数は除かれている。これによって、取り除きたい 物質は大きな振幅で振られることになり、RFイオント ラップ装置10の壁に衝突して電荷を失ってイオンとし ては存在しなくなる。前駆体はRFリング14に印加さ れるトラップ電圧によって、トラップ11内に閉じ込め られたままである。とのような操作をSWIFTとい い、との操作によって前駆体以外の不純物を取り除くこ とができる(ステップS103)。

【0051】次にTICKLEについて説明する。TI CKLEはフラグメント化に必要なエネルギーを前駆体 へ与えてフラグメントイオンを生成させて、前駆体と質 親分子である前駆体から生成されたフラグメントの量を計測して、前駆体の濃度を求める。なお、TICKLEの詳細については、上記文献"Development of a Capill ary High-performanceLiquid Chromatography Tandem M ass Spectrometry System Using SWIFTTechnology in an Ion Trap/Reflectron Time-of-flight Mass Spectrometer"を参照されたい。

[0052] TICKLEは、上述したSWIFTとは 異なり、親分子である前駆体の軌道共鳴周波数に対応す る周波数で第一エンドキャップ12と第二エンドキャッ 10 プ13との間に電圧を印加する。このときには、任意波 形発生装置20によって前記エンドキャップ間に前記周 波数の電圧を印加する。これによって、本発明に係るフ ラグメント化手段を構成する。そして、前駆体のイオン をトラップ11内に共存する他の物質と衝突させて、前 駆体をフラグメント化する。これによってTICKLE によるフラグメント化が完了する(ステップS10

4)。この発明の実施の形態1における前駆体はTCB 量分析の際における信号強度1であり、具体的にはブラであるが、質量数M=180のTCBがフラグメント化 グメントイオンの数である。したがって、この信号強度されると、質量数M=74、M=109、M=145の 20 「はフラグメントイオンの濃度と比例するので、フラグフラグメントイオンが発生する。

【0053】TICKLEによるフラグメント化が完了 したら、RFリング14に対する電圧の印加を止めて、 第二エンドキャップ13にパルス状の引出し電圧を印加 することによって、前駆体のフラグメントイオンを質量 分析計4側に引き出す(ステップS105)。とのフラ グメントイオンは質量分析計4内を飛行し、質量分析計 4によってその飛行時間が計測される。上述した通り、 飛行時間と飛行物質の質量との間には高度の対応関係が あるので、飛行時間から飛行物質の質量を検出し、この 30 質量から物質を同定できる。また、前駆体のフラグメン トイオンを計数することによって、各フラグメントイオ ンの濃度を求めることもできる。なお、実施の形態1に おいては、質量数M=74、M=109、M=145の フラグメントイオンを検出する必要があるため、それぞ れの質量数に対応する引出し電圧を第二エンドキャップ 13に印加する。これによって、それぞれの質量数を持 つフラグメントイオンの数を計数する。

【0054】この実施の形態で使用する飛行時間型の質量分析計は、数10μ秒で一回の計測が完了するため、計測時間が非常に早く、応答性に優れるという利点がある。とのため、特に、実際のプラントにおいてリアルタイムで燃焼条件を制御する際に好適である。なお、他の質量分析手段としては、電場型、RFコイル型等の質量分析手段も使用できる。特にRFコイル型はトラップ11の出口にイオン検出器を設けるだけでよいので、簡単な構造で質量分析器を構成できる。

【0055】質量分析計4によって前駆体であるTCB 縦軸に、フラグメントの質量数を移 のフラグメントイオンそれぞれのイオン数(濃度)を計 布が異性体のフラグメントパターン 数して、前駆体であるTCBのフラグメントパターンを 50 Fを整理すると、次のようになる。

得る(ステップS106)。そして、次に説明する手順 によって、このフラグメントパターンから各異性体の濃 度を求める(ステップS107)。

【0056】まず、TCBの異性体である1,3,5-TCB、1,2,4-TCB及び1,2,3-TCBの標準ガスを使用して、上記手順によってとれらのフラグメントバターンを得ておく。これは、上述したイオン化手段及びフラグメント化手段によってフラグメント化したイオンを質量分析することによって求めることができる。なお、フラグメント化においては、計測対象化学物質である質量数M=180のTCBをフラグメント化したものと同じフラグメント化手段を使用する。これは、使用するフラグメント化手段によって、得られるフラグメントバターンが異なるからである。この例においては、TICKLEによってフラグメント化する。

【0058】また、排ガスに含まれるダイオキシン類前駆体であるTCBの異性体である1,3,5-TCB、1,2,4-TCB及び1,2,3-TCBの濃度をそれぞれ C_1 、 C_2 、及び C_3 とする。そして、フラグメント化前におけるTCBの濃度をCとすると、 $C=C_1+C_3+C_3$ となる。すなわち、TCBの濃度Cは、TCBの各異性体の全濃度となる。

【0059】TCBの異性体である1,3,5-TCBのフラグメントイオンの濃度を、質量数の小さいフラグメントイオンの順に、C_{7,1-1}、C_{10,1-1}、及びC_{1,5-1}とする。 ここで、添字の74は質量数M=74のフラグメントを、添字の109は質量数M=109のフラグメントを、添字の145は質量数M=145のフラグメントを表す。そして、C_{7,1-1}/C₁=F₁₁、C_{10,5-1}/C₁=F

11、C_{1,4,5-1}/C₁=F₃₁とする。とこで、F₁₁+F₁₁+F₃₁=1となる。なお、Fはフラグメントの強度比であり、フラグメントイオンの濃度比指標である。

【0060】同様に、1,2,4TCBの強度比(濃度比指標)は、 $C_{1+1}/C_1=F_{11}$ 、 $C_{1+1}/C_2=F_{12}$ 、 $C_{1+1}/C_2=F_{11}$ となり、1,2,3-TCBの強度比(濃度比指標)は、 $C_{1+1}/C_3=F_{11}$ 、 $C_{1+1}/C_3=F_{11}$ 、 $C_{1+1}/C_3=F_{11}$ 、 $C_{1+1}/C_3=F_{11}$ となる。なお、この強度比を縦軸に、フラグメントの質量数を横軸にとって表した分布が異性体のフラグメントパターンとなる。この強度比下を整理すると、次のようになる。

1,3,5-TCBの強度比: F₁₁、F₂₁、F₃₁ 1,2,4-TCBの強度比: F₁₂、F₂₂、F₃₂ 1,2,3-TCBの強度比: F₁₃、F₂₃、F₃₃

[0061] 図4は、排ガスGs中に含まれるTCBのフラグメントバターンを示す説明図である。この図に示すように、質量数M=74、M=109及びM=145の位置に高い強度比が現れるフラグメントバターンを得るととができる。なお、排ガスに含まれるTCBには上記各異性体が含まれており、質量分析計4ではこれらの異性体を分離して計測することはできない。そこで、各10異性体の標準ガスから求めた強度比Fを利用して、排ガスGs中のTCBに含まれる各異性体の濃度を求める。この手順は次の通りである。

15

【0062】排ガスGsのフラグメントパターンにおいて、質量数M=74のフラグメントイオンの濃度指標である信号強度 I,は、 $I_1=C_1\times F_{11}+C_2\times F_{12}+C_3\times F_{13}$ で表すことができる。とこで、 C_1 は I_1 3,5-TC Bの濃度を、 C_2 は I_1 2,4-TC Bの濃度を、そして C_3 は I_2 3-TC Bの濃度を表す。同様に、質量数M=109 のフラグメントイオンの濃度指標である信号強度 I_2 4は、 $I_2=C_1\times F_{21}+C_2\times F_{22}+C_3\times F_{23}$ で表すことができる。また、質量数M=145のフラグメントイオンの濃度指標である信号強度 I_3 は、 $I_3=C_1\times F_3$ 1・ $I_3=C_1\times F_3$ 1・

【0064】なお、TCBの各異性体をフラグメント化した際に得られるフラグメントバターンが各異性体によって異なるのは、隣接した官能基の影響、すなわちオルト効果によるものと考えられる。図5は、TCBの各異性体を示す説明図である。この図から分かるように、ダイオキシン類と相関が低い1,3,5-TCBの官能基であるClは、すべてメタ位の関係であり、オルト位の関係はない(同図(a))。ところが、ダイオキシン類と相関の高い1,2,4-TCBと1,2,3-TCBとは、官能基であるClがオルト位の関係を持つ(同図(b)及び

(c))。 これによって、フラグメント化の際に与えられるエネルギーによる励起のされ方が異なるので、各異性体によってフラグメントパターンが異なるものと考えられる。

[0065] CCで、排ガスGsのTCBをフラグメント化して得られる各フラグメントイオンの信号強度 I、 $\sim I$,を 3×1 の行列 I で表し、求める各異性体の濃度 C、 $\sim C$,を 1×3 の行列 C で表し、各異性体の標準ガスから求めた強度比F、、 $\sim F$ 、,* を 3×3 の行列 F で表す。すると、上記連立方程式は、I = F C で表すことができる。したがって、I C F の逆行列 F $^{-1}$ を乗じた行列 F るC = F $^{-1}$ I を求めることによって、各異性体の濃度 C、 $\sim C$ 、* を求めることができる。

【0066】 このようにして求めたC、、C、及びC が、排ガスGsに含まれるTCB中におけるそれぞれの異性体の濃度となる。このようにして各異性体の濃度を求め、計測が終了する(ステップS108)。そして、この計測結果から、ダイオキシン類と相関の高い1、2、4-TCBの濃度C、と1、2、3-TCBの濃度C、とを用いて排ガスGs中のダイオキシン類の発生量を推定できるので、従来よりも高い精度でダイオキシン類の発生量を推定できる。

[0067]なお、上記説明においては、TCBのフラグメントイオンが3個発生した場合について説明したが、フラグメント化の方法によってはさらに多くのフラグメントイオンが発生する場合がある。このような場合でも上記検出方法は適用できる。例えば、フラグメントイオンが4個発生する場合には、

I₁=C₁×F₁₁+C₂×F₁₂+C₃×F₁,···式(1)

I₂=C₁×F₁₁+C₂×F₁₂+C₃×F₂,···式(2)

I₃=C₁×F₃₁+C₂×F₃₂+C₃×F₃,···式(3)

I₄=C₁×F₄₁+C₂×F₄₂+C₃×F₄₃···式(4)

という連立方程式を解けばよい。

【0068】また、図1に示す演算手段である演算装置 33によって上記計算をさせてもよい。例えば、演算装置 33内の記憶部34に、TCB各異性体の標準ガスから求めた強度比下、、~下、」を予め記憶させておく。そして、処理部35に、データ処理装置32(図1参照)から送られる排ガスGsに含まれているTCBのフラグメ 20トイオンの計測結果を取り込ませる。次に、処理部35は記憶部34から強度比下、、~下、を3×3の行列の形で読み込んで、この逆行列下でを計算する。そして、この逆行列とフラグメントイオンの計測結果から求めた行列 I との積から、各異性体の濃度C、~C、を求める。また、記憶部34には、予め逆行列下で記憶させておいてもよい。このようにすると、処理部35で逆行列下で演算しなくともよいので、その分処理速度を向上させることができる。

[0069]なお、記憶部34は、ハードディスク装置 50 や光磁気ディスク装置、フラッシュメモリ等の不揮発性

のメモリや、CD-ROM等のような読み出しのみが可 能な記憶媒体、RAM(Random Access Memory)のよう な揮発性のメモリ、あるいはこれらの組み合わせにより 構成されるものとする。また、この処理部35は専用の ハードウエアにより実現されるものであってもよく、ま た、この処理部35はメモリ及びCPU(中央演算装 **胃) により構成され、処理部35の機能を実現するため** のプログラム (図示省略) をメモリにロードして実行す ることによりその機能を実現させるものであってもよ い。また、この演算装置33には、周辺機器として入力 10 装置、表示装置など(いずれも図示省略)をメモリにロ ードして実行することによりその機能を実現させるもの であってもよい。

17

【0070】(実施の形態2)実施の形態1において は、排ガスに含まれるTCBの異性体のうち、1,3,5-T CBと、1.2.4-TCBと、1,2,3-TCBとの濃度をそれ ぞれ求め、ダイオキシン類と相関の高い異性体の濃度を 用いてダイオキシン類の発生量を推定した。しかし、実 際の計測においては、ダイオキシン類と相関の高い1.2. 4-TCBと1,2,3-TCBとのフラグメントパターンに明 20 にして推定した1,2,4-TCBの濃度C,及び1,2,3-TC 確な違いが生じない場合がある。とのような場合には、 1,2,4-TCBの濃度C,と1,2,3-TCBの濃度C,との和 までしか求めることができない。しかし、ダイオキシン 類との相関が高い異性体は1,2,4-TCB及び1,2,3-TC Bであるので、これらの和まで分かればダイオキシン類 の発生量を推定するととができる。実施の形態2におい ては、1,2,4-TCB及び1,2,3-TCBの濃度からダイオ キシン類の発生量を推定する方法について説明する。 [0071] 具体的には、 $I_1 = C_1 \times F_{11} + C_1 \times F_{12}$ $+C_{1}\times F_{1}$, $I_{2}=C_{1}\times F_{2}+C_{2}\times F_{2}+C_{3}\times F_{2}$ F_{11} 、及び $I_1 = C_1 \times F_{11} + C_2 \times F_{12} + C_3 \times F_{13}$ の連 立方程式を解くが、F,1=F,3、F,1=F,3、F,1=F 」、である。なお、添字や文字の意味は上述したものと同 じである。との連立方程式を解くと、C,及びC,+C, =Aという解を得ることができる。このように、ダイオ キシン類との相関が高い異性体である1,2,4-TCBと1, 2,3-TCBとの濃度であるC,とC,との和を得ることが できる。

[0072]1,2,4-TCB及び1,2,3-TCBはダイオキ シン類の発生量と高い相関がある。図6は、1,2,4-TC Bの発生量とダイオキシン類の発生量との関係を示した 説明図である。また、図7は、1,2,3-TCBの発生量と ダイオキシン類の発生量との関係を示した説明図であ る。1,2,4-TCBの濃度C,及び1,2,3-TCBの濃度C, それぞれの値を別個に求めることはできない。しかし、 図6及び7に示すように、1,2,4-TCBの濃度C,とダ イオキシン類の発生量との関係、及び1,2,3-TCBの濃 度C,とダイオキシン類の発生量との関係は近似してい

[0073] このため、いずれかの関係を用いて1,2,4-50

TCBの濃度C,と1,2,3-TCBの濃度C,との和A=C ;+C,からダイオキシン類の発生量を推定することがで きる。例えば、1,2,4-TCBの濃度C,とダイオキシン 類の発生量Dとの関係がD=a×C,+bで表されると き、この関係式のC, にA=C,+C,を代入して求めた D=a×A+bをダイオキシン類の発生量と推定する (a、bは任意の定数)。このようにして推定したダイ オキシンの発生量は、ダイオキシン類の発生量と相関の 低い1,3,5-TCBを除いて推定しているので、従来より も高い精度を得ることができる。

【0074】また、実験等によって、ダイオキシン類の 濃度と、1.2.4-TCB及び1,2,3-TCBの濃度との関係 を求め、ことからダイオキシン類の発生量を推定しても よい。また、TCBの異性体は、塩素とベンゼン環の反 応温度によって発生割合が変化するので、焼却炉等内に おける燃焼温度が分かれば、1,2,4-TCBと1,2,3-TC Bとの発生割合を推定することができる。これによっ て、1,2,4-TCBの濃度C,と1,2,3-TCBの濃度C,と の和から個々の濃度を推定することができる。とのよう Bの濃度C」からそれぞれダイオキシン類の発生量を推 定して両者を加算すれば、排ガス中におけるダイオキシ ン類の発生量を推定できる。

【0075】また、1,2,4-TCB及び1,2,3-TCBの濃 度C,及びC,の和の変化を監視すれば、ダイオキシン類 の発生量がどのように変化しているかを知ることができ る。とれによって、焼却炉等の燃焼状態を簡易的にモニ ターするととができる。そして、ダイオキシン類の発生 量を時間の推移とともに知ることができれば、焼却炉等 30 の燃焼状態を制御することができる。

【0076】(実施の形態3)ダイオキシン類の前駆体 には同位体を持つものがあり、同じ前駆体であっても異 なる質量数を持つ。実施の形態1及び2で説明したTC Bは、質量数Mが180と182と184との同位体を 持っている。とれは、ベンゼン環に結合している塩素の 質量数に35と37との二種類があるためである。との ような同位体を持つ前駆体においては、一種類の質量数 に係る前駆体の密度は、当該前駆体全体の密度よりも低 いため、一種類の質量数のみを質量分析計4における計 測対象物質とすると、計測感度の低下を招いてしまう。 【0077】上記TCBを例にとれば、質量数M=18 OのTCBのみを計測対象とした場合には質量数M=1 82及び質量数M=184のTCBは計測されない。そ の結果、TCB全体としては計測されなかった質量数M = 182及び質量数M=184のTCBの分だけ、濃度 が低く検出されるととになる。特に、焼却炉の排ガスに 存在するダイオキシン類の前駆体であるTCBはその濃 度が極めて低いため、少しでも検出感度を高くする必要 がある。

【0078】そとで、ダイオキシン類前駆体の同位体の

うち少なくとも2個の同位体すべてまでをフラグメント化して、TCBの持つ3個の異性体を計測すれば、上記計測感度の低下という問題は回避できる。とこでは、TCBの同位体を例にとって説明するが、この発明の適用対象はTCBに限られるものではなく、同位体を持つ前駆体であればすべて適用できる。図8は、との発明の実施の形態3に係るTICKLE波形の周波数スペクトルを、質量数を横軸として変換した説明図である。なお、同図(a)は、TCBイオンにおける同位体の分布を示している。

19

[0079] この発明においては、例えば、前駆体のすべての同位体をフラグメント化したり、すべての同位体から理論的に濃度の低い同位体を除いた前駆体の同位体を納いた前駆体の同位体をフラグメント化したりすることができる。このときのTICKLE波形は、少なくとも2個の前駆体のうちすべてまでの同位体に対する質量数を含むようにした、広い共鳴周波数帯の範囲で大きな振幅を与える周波数スペクトルを逆フーリエ変換したものが使用できる(図8(b))。

[0080]また、共鳴周波数がイオンに影響を与える 質量数にはある幅があるため、振幅が一定の周波数スペ クトルを使用した場合、質量数が最大と最小の同位体に はTICKLEがかかりにくく、中間の同位体は相対的 にTICKLEがかかりやすいという現象がある。この ため、前駆体同位体の質量数が最大の部分と最小の部分 とにおける電圧振幅を大きくとった周波数スペクトルと すると、TICKLEの対象としている複数の同位体す べてに略一定のTICKLEをかけることができる。と れによって、略均一にフラグメント化させることができ る。また、フラグメント化の対象である同位体のうち質 量数が最大の部分と最小の部分とにおいて電圧振幅を大 きくとり、質量数が中程度の部分における電圧振幅を相 対的に小さくとった周波数スペクトルとしてもよい(図 8 (c) の実線)。 さらに、イオンの信号強度が相対的 に低い同位体においては、電圧振幅をイオンの信号強度 が相対的に高い同位体における電圧振幅よりも小さくし た周波数スペクトルを使用してもよい(図8(c)の破 線)。

[0081]一方、ある一つの同位体と略同一の質量数 40をもつ不純物が大量に存在する場合がある。例えば、図 8 (d) において質量数180のTCB同位体と同じ質量数を持つ不純物が大量に存在していたとする。このような場合には、その同位体を除いた複数の同位体をフラグメント化し、大量の不純物をフラグメント化させないことで、精度の高い計測を行うようにしてもよい。この場合には、その同位体(ここではTCBの同位体)の中から同じ質量数に不純物があまり含まれていない複数の同位体を選び、その質量数に対応する複数の共鳴周波数からなる周波数スペクトルを逆フーリエ変換したTIC 50

KLE波形を使用することができる(図8(d))。 【0082】実施の形態3に係る化学物質の検出方法によれば、前駆体に複数存在する同位体のうち、少なくとも2個の同位体すべてまでをフラグメント化してTCBのフラグメントパターンを求めるので、TCB濃度の計測精度をより向上させることができる。これによって、より高い精度で各異性体の濃度を求めることができるの

側精度をより同上させることができる。これによって、より高い精度で各異性体の濃度を求めることができるので、ダイオキシン類の推定精度もより向上する。これによって、焼却炉等の内部における燃焼状態もより精密に10 制御できる。

[0083] (実施の形態4) 前駆体にも同位体は存在するが、前駆体のフラグメントにも同様に同位体が存在する。したがって、フラグメントの計測についても実施の形態3で述べたことと同様な問題が存在する。従来は、一つのフラグメントのみで前駆体の濃度を計測するか、フラグメントの出現パターン、すなわち、どの質量数のフラグメントが表れるかを調べることによって、前駆体の濃度を見積もっていた。

[0084]しかし、焼却炉の排ガス中に含まれるダイ オキシン類の前駆体のように、極めて低い濃度でしか存在しない物質において、フラグメントの一つの同位体のみを計測したのでは、十分な感度の計測はできない。また、複数のフラグメントによるパターンマッチングであっても、一つの同位体のみでは絶対的なフラグメントの量が少なく、統計的に濃度を見積もるためには不十分である。

[0085] そこで、前駆体から生成されるフラグメントの同位体のうち少なくとも2種類を計測対象とする。 具体的には、あるフラグメントのスペクトル(信号電圧)のうち、複数現れる同位体のスペクトルの最大値をそれぞれ加算した値、又は、複数現れる同位体のスペクトルの面積をそれぞれ加算した値を質量分析計4の計測値として使用する。

[0086] このようにすると、あるフラグメントの同位体をすべて使用できるので、計測対象物質の濃度が極めて低い場合であっても、質量分析計4における計測では計測感度を高くできる。これによって、計測感度を高くして前駆体のフラグメントバターンを求めることができるので、より高い精度で各異性体の濃度を求め、ダイオキシン類の濃度を見積もることができる。

[0087]また、ある同位体の質量数に不純物のフラグメントが表れている場合等のように、ノイズ成分の大きなスペクトルが存在する場合には、その同位体のスペクトルを除いた同位体の質量数を選択して、計測対象物の濃度を求めればよい。このようにすると、不純物等のノイズを排除できるので、より精度の高い計測ができる。これによって、より高い精度でダイオキシン類の濃度を見積もることができる。

[0088]

【発明の効果】以上説明したように、この発明に係る化

学物質の検出方法(請求項 l) では、ダイオキシン類前 駆体の異性体濃度を、当該前駆体のフラグメントイオン の濃度指標と、との前駆体の異性体の標準気体から求め た当該異性体のフラグメントの濃度比指標とから求める ようにした。このため、ダイオキシン類と相関の低い異 性体とダイオキシン類と相関の高い異性体との濃度を知 ることができる。その結果、ダイオキシン類の発生量を 従来よりも高い精度で推定することができるので、焼却 炉等の燃焼状態を従来よりも高い精度で制御できる。こ れにより、ダイオキシン類の発生量を従来よりも低くで 10 きる。

21

【0089】また、質量分析装置等を用いた質量分析工程によって、ダイオキシン類前駆体のフラグメントパターンを求めるようにしたので、短時間でフラグメントパターンを求めることができる。さらに、ダイオキシン類と相関の高い異性体の濃度は、数学的計算によって求めることができるので、電子計算機等の計算手段によれば極めて短時間で計算結果を得ることができる。その結果、ダイオキシン類と相関の高い異性体の濃度を短時間で求めることができる。

[0090]また、この発明に係る化学物質の検出方法 (請求項2)では、前駆体のイオン化ポテンシャルより も大きく、当該イオン化ポテンシャルと上記前駆体のイオンの解離エネルギーとの和よりも小さいエネルギーを 与えて、ダイオキシン類の前駆体をイオン化するように した

【0091】 このため、この化学物質の検出方法においては前駆体を壊さずにイオン化できるので、上記化学物質の検出方法の奏する効果の他に、イオン化効率を高くして質量分析工程における検出感度を高くできるという効果も奏する。また、このイオン化においては、夾雑物の発生を少なく抑えることができるので、除去すべき夾雑物も極めて少なくできる。その結果、夾雑物除去に要するエネルギーを低く抑えることができるので、残すべき前駆体であるダイオキシン類前駆体を壊さないで済み、質量分析工程における検出感度を高くできる。

[0092]また、この発明に係る化学物質の検出方法(請求項3)では、ダイオキシン類の前駆体のイオン化ポテンシャルよりも高く当該イオン化ポテンシャルに4 eVを加算した値以下のエネルギーをこの前駆体に与え 40 るようにした。また、この発明に係る化学物質の検出方法(請求項4)では、イオン化工程において、波長が50nm以上200nm以下の光によってダイオキシン類の前駆体をイオン化するようにした。このため、余計なフラグメントを発生させずに不純物を除去できる。また、この発明に係る化学物質の検出方法(請求項5)では、イオン化工程において、真空紫外光をダイオキシン類の前駆体に照射するようにしたので、取り扱いが容易となる。

[0093]また、この発明に係る化学物質の検出方法 50

(請求項6)では、フラグメント化工程においてTIC KLE波形をダイオキシン類の前駆体のイオンに与える ことによってこれをフラグメント化するようにした。このため、ほとんどすべてのダイオキシン前駆体のフラグメントを質量分析手段の計測対象とすることができるので、質量分析工程における検出感度を高くできる。そして、ダイオキシン類と相関の高い異性体を選択的に検出できる作用と相まって、より緻密に焼却炉等の燃焼状態を制御できる。

10 【0094】また、この発明に係る化学物質の検出装置 (請求項7)では、イオン化手段と、フラグメント化手 段と、質量分析手段と、演算手段とを備えた。そして、 複数存在するダイオキシン類の前駆体の異性体濃度を、 前駆体のフラグメントイオンの濃度指標と、この前駆体 の異性体の標準気体から求めた当該異性体のフラグメントの濃度比指標とから求めるようにした。このため、す べての前駆体からダイオキシン類と相関の高い異性体の 濃度を選択的に計測することができるので、ダイオキシン類の発生量を従来よりも高い精度で推定できる、その 20 結果、焼却炉等の燃焼状態を従来よりも高い精度で制御 でき、ダイオキシン類の発生量を従来よりも低くでき る。

[0095]また、との化学物質の検出装置は、質量分析手段によってダイオキシン類前駆体のフラグメントバターンを求めるので、短時間でフラグメントバターンを求めることができる。そして、ダイオキシン類と相関の高い異性体の濃度は、数学的計算によって求めることができるので、短時間で計算結果を得ることができる。その結果、この化学物質の検出方法においては、短い時間でダイオキシン類と相関の高い異性体の濃度を求めることができ、ダイオキシン類をリアルタイムで測定できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】との発明の実施の形態1に係る化学物質の検出 装置を示す説明図である。

[図2] との発明の実施の形態1に係る化学物質の検出 方法を示すフローチャートである。

【図3】TCBの異性体それぞれのフラグメントパターンを表す説明図である。

【図4】 排ガスGs 中に含まれるTCBのフラグメントパターンを示す説明図である。

【図5】 TCBの各異性体を示す説明図である。

【図6】1,2,4-TCBの発生量とダイオキシン類の発生量との関係を示した説明図である。

【図7】1,2,3-TCBの発生量とダイオキシン類の発生量との関係を示した説明図である。

【図8】との発明の実施の形態3に係るTICKLE波形の周波数スペクトルを、質量数を横軸として変換した説明図である。

50 【符号の説明】

24

23

1 イオン化室

2 ガス導入装置

3 真空紫外光ランプ

4 質量分析計

5 ガス噴射管

6 ヒータ

10 RFイオントラップ装置

11 トラップ

12 第一エンドキャップ

13 第二エンドキャップ

14 RFリング

*20 任意波形発生装置

21 高周波電源装置

30 イオン検出器

31 プリアンプ

32 データ処理装置

33 演算装置

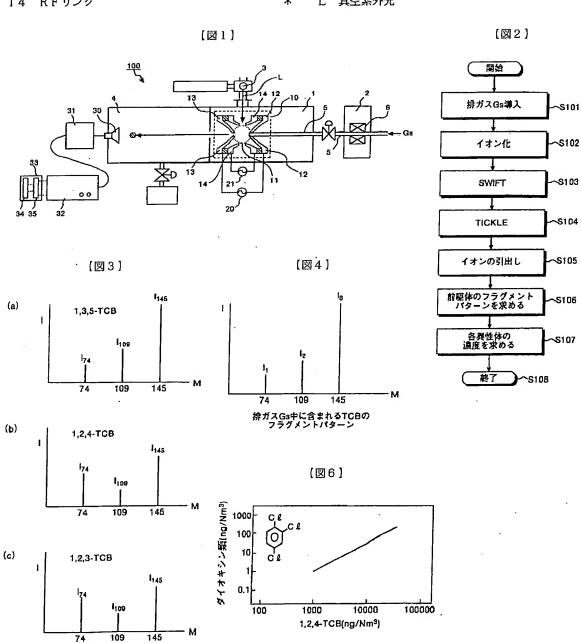
34 記憶部

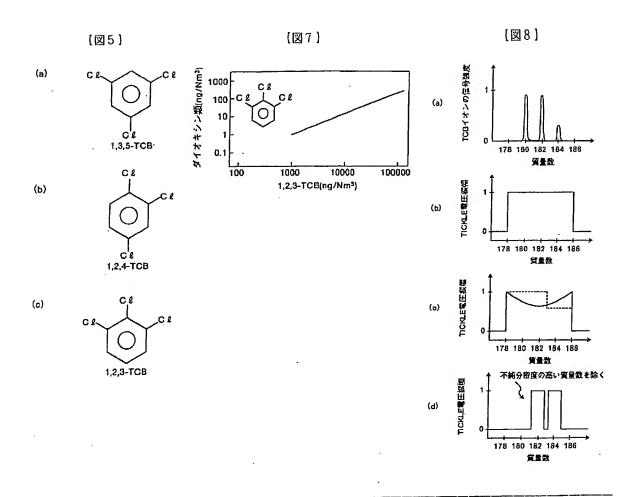
35 処理部

100 化学物質の検出装置

10 Gs 排ガス

L 真空紫外光





フロントページの続き

(72)発明者 団野 実

横浜市金沢区幸浦一丁目8番地1 三菱重

工業株式会社横浜研究所内

(72)発明者 鶴我 薫典

横浜市金沢区幸浦一丁目8番地1 三菱

工業株式会社基盤技術研究所内

(72)発明者 栗林 志頭真

横浜市金沢区幸浦一丁目8番地1 三菱重

工業株式会社基盤技術研究所内